

H10N 他に分類されない電気的固体装置 [2023.01]

注

このサブクラスでは、セクション C の注 (3) の周期表中に示された I-VIII 族のシステムが用いられる。

サブクラス内の索引

熱電装置または熱磁気装置

熱電装置..... 10/00,15/00

熱磁気装置..... 15/00

集積装置または複数の装置の組立体..... 19/00

圧電装置、電歪装置または磁歪装置

圧電装置または電歪装置..... 30/00

磁歪装置..... 35/00

集積装置または複数の装置の組立体..... 39/00

電流磁気装置または類似の磁気効果装置電流

磁気装置..... 50/00

ホ - ル効果装置..... 52/00

集積装置または複数の装置の組立体..... 59/00

超電導装置

超電導装置..... 60/00

集積装置または複数の装置の組立体..... 69/00

他の電気的固体装置

電位障壁を有しない、整流、増幅、発振またはスイッチングに特に適した、電位障壁または表面障壁を有しない固体装置..... 70/00

集積装置または複数の装置の組立体..... 79/00

バルク負性抵抗効果装置..... 80/00

集積装置または複数の装置の組立体..... 89/00

他に分類されない電気的固体薄膜または厚膜装置

97/00

このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項

99/00

熱電装置または熱磁気装置 [2023.01]

10/00

異種材料の接合からなる熱電装置、すなわちゼ - ベック効果またはペルチェ効果を示す装置 (集積装置または複数の装置の組立体 H10N19/00) [2023.01]

S 感温半導体素子または感温スイッチ

Z その他のもの

このグル - プは、他の熱電効果または熱磁気効果を示すまたは示さない、異種材料の接合からなる熱電装置を包含する [2023.01]

10/01

・製造または処理 [2023.01]

10/10

・ゼ - ベック効果またはペルチェ効果のみで動作するもの [2023.01]

C 回路に特徴があるペルチェまたはゼ - ベック装置

Z その他のもの

10/13

・接合部の熱交換手段に特徴のあるもの [2023.01]

10/17

・装置を形成するセルまたは熱電対の構造または配列に特徴のあるもの [2023.01]

A 熱電対の構造または配列、例 . サ - モパイル

Z その他のもの、例 . サ - モモジュールまたは発電用

10/80

・構造的細部 [2023.01]

10/81

・接合部の構造的細部 [2023.01]

10/813

・分離できる接合部、例 . ばねを用いるもの [2023.01]

10/817

・分離できない接合部、例 . セメント接合されたもの、焼結されたものまたははんだ付けされたもの [2023.01]

10/82

・相互接続 [2023.01]

10/85

・熱電性の活性材料 [2023.01]

10/851

・無機組成物からなるもの [2023.01]

10/852

・・・・テルル、セレンまたは硫黄からなるもの [2023.01]

10/853

・・・・ヒ素、アンチモンまたはビスマスからなるもの (H10N10/852 が優先) [2023.01]

10/854

・・・・金属のみからなるもの (H10N10/852,H10N10/853 が優先) [2023.01]

10/855

・・・・ホウ素、炭素、酸素または窒素を含有する化合物からなるもの [2023.01]

10/856

・・・・有機組成物からなるもの [2023.01]

10/857

・・・・材料内部で連続的にまたは不連続的に変化する組成物からなるもの [2023.01]

15/00

異種材料の接合を有しない熱電装置; 熱磁気装置、例 . ネルンスト - エッチングスハウゼン効果を利用するもの (集積装置または複数の装置の組立体 H10N19/00) [2023.01]

15/10

・誘電率の温度変化を利用する熱電装置、例 . キュリ - 温度の上下で作動するもの [2023.01]

15/20

・透磁率の温度変化を利用する熱磁気装置、例 . キュリ - 温度の上下で作動するもの [2023.01]

19/00

グル - プ H10N10/00-H10N15/00 に包含される、少なくとも 1 つの熱電素子または熱磁気素子を備える、集積装置または複数の装置の組立体 [2023.01]

圧電装置、電歪装置または磁歪装置 [2023.01]

30/00

圧電装置または電歪装置 (集積装置または複数の装置の組立体 H10N39/00) [2023.01]

30/01

・製造または処理 [2023.01]

30/02

・被覆またはケ - スの形成 [2023.01]

30/03

・・・・圧電部品または電歪部分を含む装置の組み立て [2023.01]

30/04

・・・・圧電特性または電歪特性を修正する処理、例 . 分極の特徴、振動の特徴またはモ - ド同調 [2023.01]

30/045

・・・・分極方法による [2023.01]

30/05

・・・・多層圧電装置または電歪装置、またはそれら部品の製造、例 . 圧電体と電極の積層によるもの [2023.01]

30/053

・・・・圧電体または電歪体と電極を同時焼結による [2023.01]

30/057

・・・・バルク圧電体または電歪体と電極の積層による [2023.01]

30/06

・・・・電極または相互接続、例 . リ - ドまたは端子、の形成 [2023.01]

30/063

・・・・相互接続、例 . 積層型圧電装置または積層型電歪装置の接続電極、の形成 [2023.01]

30/067

・・・・積層型圧電装置または積層型電歪装置の単層電極の形成 [2023.01]

30/07

・・・・電気素子または他の基台上への、圧電部品または電歪部品、またはそれらの本体の形成 [2023.01]

30/071

・・・・共通基板上への、圧電部品または電歪部品と、半導体素子または他の回路素子との取付け [2023.01]

30/072

・・・・圧電体または電歪体の積層または接着による [2023.01]

30/073

・・・・金属溶融または接着剤による [2023.01]

30/074

・・・・圧電層または電歪層の堆積による、例 . エアロゾル印刷またはスクリーン印刷 [2023.01]

30/076	・・・気相堆積による [2023.01]	P	感磁部パタ - ン
30/077	・・・液相堆積による [2023.01]	B	バイアス磁界
30/078	・・・ゾルゲル堆積による [2023.01]	U	用途
30/079	・・・下地膜を用いる方法, 例 . 成長制御 [2023.01]	Z	その他のもの
30/08	・・圧電体または電歪体の成形または機械加工 [2023.01]	50/20	・スピン偏極電流制御装置 (磁気抵抗素子 H10N50/10) [2023.01]
30/081	・・・マスクを用いた塗布または堆積による, 例 . リフトオフ [2023.01]	50/80	・構造的細部 [2023.01]
30/082	・・・エッチングによる, 例 . リソグラフィ [2023.01]	D	電極
30/084	・・・型成形または押出成形による [2023.01]	H	保護層
30/085	・・・機械加工による [2023.01]	P	可動部材に特徴があるもの, 例 . ポテンショメ - タ
30/086	・・・研磨または研削による [2023.01]	Z	その他のもの
30/088	・・・切削またはダイシングによる [2023.01]	50/85	・・活性領域の材料 [2023.01]
30/089	・・・パンチングによる [2023.01]	52/00	ホ - ル効果装置 (集積装置または複数の装置の組立体 H10N59/00) [2023.01]
30/09	・・圧電材料または電歪材料の形成 [2023.01]	A	回路に特徴があるもの
30/092	・・・複合材料の形成 [2023.01]	C	固体インダクタ
30/093	・・・無機材料の形成 [2023.01]	S	半導体
30/095	・・・溶融による [2023.01]	M	強磁性体
30/097	・・・焼成による [2023.01]	P	感磁部パタ - ン
30/098	・・・有機材料の形成 [2023.01]	B	バイアス磁界
30/20	・電気的入力および機械的出力を有するもの, 例 . アクチュエ - タまたは振動子として機能するもの [2023.01]	U	用途
30/30	・機械的入力および電気的出力を有するもの, 例 . 発電機またはセンサとして機能するもの [2023.01]	Z	その他のもの
30/40	・電気的入力および電気的出力を有するもの, 例 . 変圧器として機能するもの [2023.01]	52/01	・製造または処理 [2023.01]
30/50	・積層構造または多層構造を有するもの [2023.01]	52/80	・構造的細部 [2023.01]
30/60	・同軸ケ - ブルの構造を有するもの [2023.01]	D	電極
30/80	・構造的細部 [2023.01]	H	保護層
30/85	・・圧電性または電歪性の活性材料 [2023.01]	Z	その他のもの
30/853	・・・セラミック組成物 [2023.01]	52/85	・・活性領域の材料 [2023.01]
30/857	・・・高分子組成物 [2023.01]	59/00	グル - プ H10N50/00-H10N52/00 に含まれる, 少なくとも 1 つの電流磁気素子またはホ - ル効果素子を備える, 集積装置または複数の装置の組立体 (磁気抵抗ランダムアクセスメモリ [MRAM] 装置 H10B61/00) [2023.01]
30/87	・・電極または相互接続, 例 . リ - ドまたは端子 [2023.01]	超電導装置 [2023.01]	
30/88	・・取付具; 支持具; 被覆; ケ - ス [2023.01]	60/00	超電導装置 (集積装置または複数の装置の組立体 H10N69/00) [2023.01]
35/00	磁歪装置 (集積装置または複数の装置の組立体 H10N39/00) [2023.01]	A	超電導性を利用した装置
35/01	・製造または処理 [2023.01]	G	・磁気を利用した装置
35/80	・構造的細部 [2023.01]	M	・マイスナ - 効果を利用した装置
35/85	・・磁歪性の活性材料 [2023.01]	C	線材を除く超電導体の接続
39/00	グル - プ H10N30/00-H10N35/00 に含まれる, 少なくとも 1 つの圧電素子, 電歪素子または磁歪素子を備える, 集積装置または複数の装置の組立体 [2023.01]	S	磁気シ - ルド材
電流磁気装置または類似の磁気効果装置 [2023.01]		Z	その他のもの
50/00	電流磁気装置 (ホ - ル効果装置 H10N52/00; 集積装置または複数の装置の組立体 H10N59/00) [2023.01]	60/01	・製造または処理 [2023.01]
50/01	・製造または処理 [2023.01]	B	薄膜の製造方法
50/10	・磁気抵抗素子 [2023.01]	C	・ジョセフソン素子用
A	回路に特徴があるもの	D	・積層
S	半導体磁気抵抗素子	F	薄膜の加工方法
M	強磁性体	J	ジョセフソン素子の製造方法
		K	ジョセフソン素子の製造装置
		W	回路基板の製造方法
		Z	その他のもの
		60/10	・接合に基づく装置 [2023.01]
		G	超電導トランジスタ; 多端子素子
		K	回路に特徴があるもの
		Z	その他のもの
		60/12	・・ジョセフソン効果装置 [2023.01]
		A	ジョセフソン素子
		B	・メモリ素子
		C	・ソリトン・デバイス
		D	・磁気センサ, 電磁場の発生または検出電圧標準用

	Z	その他のもの
60/20		・永久超電導装置 [2023.01]
	A	永久電流用機械式スイッチ
	Z	その他のもの
60/30		・超電導状態と正常状態との間で切換可能な装置 [2023.01]
60/35		・・クライオトロン [2023.01]
60/355		・・・電力用クライオトロン [2023.01]
60/80		・構造的細部 [2023.01]
	A	超電導素子の実装, 例. マイクロピン
	B	超電導素子用薄膜
	W	超電導素子用回路基板
	D	超電導体の積層
	Z	その他のもの
60/81		・・容器; 取付具 [2023.01]
60/82		・・電流路 [2023.01]
60/83		・・素子の形状 [2023.01]
60/84		・・超電導状態と正常状態との間で切換可能な装置のための切換手段 [2023.01]
60/85		・・超電導の活性材料 [2023.01]
	A	合金; 金属間化合物系
	B	有機物系
	C	セラミック系
	Z	その他のもの
69/00		グル - プ H10N60/00 に包含される, 少なくとも 1 つの超電導素子を備える, 集積装置または複数の装置の組立体 [2023.01]
他の電気的固体装置 [2023.01]		
70/00		電位障壁を有しない, 整流, 増幅, 発振またはスイッチングに特に適した固体装置 (集積装置または複数の装置の組立体 H10N79/00) [2023.01]
	A	非晶質半導体に関するもの
	B	・酸化物ガラスに関するもの
	C	バルクまたは薄膜型に関するもの
	Z	その他のもの
70/10		・固体進行波装置 [2023.01]
70/20		・多安定スイッチング装置, 例. メモリスタ [2023.01]
79/00		グル - プ H10N70/00 に包含される, 少なくとも 1 つの固体素子を備える, 集積装置または複数の装置の組立体 (ReRAM 装置 H10B63/00; PCRAM 装置 H10B63/10) [2023.01]
80/00		バルク負性抵抗効果装置 (集積装置または複数の装置の組立体 H10N89/00) [2023.01]
80/10		・ガン効果装置 [2023.01]
89/00		グル - プ H10N80/00 に包含される, 少なくとも 1 つのバルク負性抵抗効果素子を備える, 集積装置または複数の装置の組立体 [2023.01]
97/00		他に分類されない電気的固体薄膜または厚膜装置 [2023.01]
99/00		このサブクラスの他のグル - プに分類されない主題事項 [2023.01]

